

- фотодетектирующих в ИК-области тонкослойных структур Ge:Sb/Ge методами ионной имплантации, вакуумного осаждения и импульсного отжига. ^{1) Казанский физико-технический институт, Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН», Казань. 2) Институт физики микроструктур, Федеральный исследовательский центр «Институт прикладной физики РАН», Нижний Новгород.}
- Ч_25** **A.B.Войцеховский^{1,2)}**, С.Н.Несмелов¹⁾, С.М.Дзядух¹⁾, А.П.Коханенко¹⁾. Электрофизические и оптические свойства органических светодиодных структур с эмиссионным слоем ЯК-203. ^{1) Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск. 2) Сибирский физико-технический институт ТГУ, Томск.}
- Ч_26** **A.B.Войцеховский^{1,2)}**, С.Н.Несмелов¹⁾, С.М.Дзядух¹⁾. Адmittанс гибридных органо-неорганических структур на основе пентацена в широком диапазоне температур. ^{1) Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск. 2) Сибирский физико-технический институт ТГУ, Томск.}
- Ч_27** **M.П.Гамбарян¹⁾**, С.Г.Черкова¹⁾, В.А.Володин^{1,2)}. ИК-фотолюминесценция плёнок Ge_xSi_yO_z: вклад дефектов и нанокластеров германия. ^{1) Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. 2) Новосибирский государственный университет, Новосибирск.}
- Ч_28** **Н.В.Латухина¹⁾**, И.М.Жильцов¹⁾, М.Б.Степихова²⁾. Оптические и электрические свойства диодных структур на базе пористого кремния с эрбием. ^{1) Самарский национальный исследовательский университет им.академика С.П. Королева, Самара. 2) Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород.}
- Ч_29** **К.Д.Мынбаев^{1,2)}**, А.А.Семакова^{1,2)}, С.Н.Липницкая¹⁾, Н.Л.Баженов²⁾, А.В.Черняев^{2,3)}, С.С.Кижсаев³⁾, Н.Д.Стоянов³⁾. Спонтанное и стимулированное излучение в светодиодных гетероструктурах с активной областью из InAs. ^{1) Университет ИТМО, Санкт-Петербург. 2) Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург. 3) ООО «Микросенсор Технолоджи», Санкт-Петербург.}
- Ч_30** **Н.А.Солдатов¹⁾**, Д.В.Дмитриев¹⁾, К.С.Журавлев^{1,2)}. Разработка мощных ИК диодов с РВО на 850 и 920 нм методом МЛЭ. ^{1) Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова, Новосибирск. 2) Новосибирский государственный университет, Новосибирск.}
- Ч_31** **К.В.Феклистов¹⁾**, А.В.Гуляев¹⁾, А.Г.Лемзяков²⁾. Фотолюминесценция эрбия в In₂O₃. ^{1) Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. 2) Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск.}
- Ч_33** **А.И.Козлов¹⁾**, А.Р.Новоселов²⁾, В.Н.Овсяк¹⁾. Дизайнерские принципы устранения потерь изображений в мозаичных фотоприемниках сверхвысокой развернутости. ^{1) Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск. 2) Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск.}
- Ч_34** **А.В.Вишняков¹⁾**, В.В.Васильев¹⁾, И.В.Сабинина¹⁾, Г.Ю.Сидоров¹⁾, В.А.Стучинский¹⁾. Моделирование пространственного разрешения ИК КРТ ФПУ методом Монте Карло. ^{1) Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.}
- Ч_35** **А.Г.Паулиш^{1,2)}**, П.С.Загубисало¹⁾. Коэффициенты тензорчувствительности датчиков механических напряжений на разных физических принципах. ^{1) Новосибирский филиал ИФП СО РАН «Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники», Новосибирск. 2) Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.}